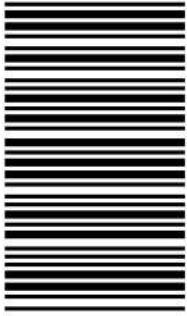


کد کنترل

479

A



479A

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) - سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

رشته نانوشیمی - (کد ۲۲۴۴)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: - ریاضیات عمومی - شیمی پایه (شیمی آلی، معدنی، تجزیه و شیمی فیزیک) - مبانی نانو تکنولوژی	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخنامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

۱- مقدار انتگرال $\int_0^{\pi} \sin(\sin^2 x) \cdot \cos(\cos^2 x) dx$ کدام است؟

(۱) $\frac{\pi}{2} \cos 1$

(۲) $\frac{\pi}{4} \cos 1$

(۳) $\frac{\pi}{2} \sin 1$

(۴) $\frac{\pi}{4} \sin 1$

۲- مقدار $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$ کدام است؟

(۱) e

(۲) 2

(۳) 1

(۴) $e-1$

۳- مقدار $\lim_{t \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \int_0^t [\sqrt{\sin x}] dx$ کدام است؟

(۱) $\frac{\pi}{3}$

(۲) 0

(۳) $\frac{\pi}{2}$

(۴) $\frac{2\pi}{3}$

۴- مقدار $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n-1} \right)$ کدام است؟

(۱) ۰

(۲) $\ln 2$

(۳) $\ln 3$

(۴) ∞

۵- نمودار کدام تابع، نمودار تابع $f(x) = x - \sin x$ را در مبدأ مختصات با زاویه $\frac{\pi}{4}$ قطع می کند؟

(۱) $g(x) = x + \sin x$

(۲) $g(x) = 2x + \sin x$

(۳) $g(x) = 2x - \sin x$

(۴) $g(x) = x + 2 \sin x$

۶- مجانب مایل تابع $f(x) = 2x + 5 + \frac{2x^2 - 5x + 1}{x-1}$ کدام است؟

(۱) $y = 4x + 2$

(۲) $y = 4x + 5$

(۳) $y = 2x + 5$

(۴) مجانب مایل ندارد.

۷- مساحت ناحیه محصور بین نمودار تابع $y = x^3$ ، خط مماس بر $y = x^3$ در نقطه $(1, 1)$ و زیر خط $y = -1$ ، کدام است؟

(۱) $\frac{55}{12}$

(۲) $\frac{60}{12}$

(۳) $\frac{65}{12}$

(۴) $\frac{70}{12}$

۸- مساحت ناحیه واقع در صفحه xy و محدود به منحنی $\begin{cases} x = \cos 2\theta - 2 \cos \theta \\ y = \sin 2\theta + 2 \sin \theta \end{cases}$ کدام است؟

(۱) $\frac{\pi}{2}$

(۲) 2π

(۳) 3π

(۴) π

۹- مشتق جهتی تابع $f(x, y, z) = y^2 + \ln(x^2 + z^2)$ در نقطه $M(1, 2, -1)$ و در امتداد بردار $\vec{A} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ کدام است؟

$$-\frac{5}{3} \quad (1)$$

$$-\frac{8}{3} \quad (2)$$

$$\frac{7}{3} \quad (3)$$

$$-\frac{4}{3} \quad (4)$$

۱۰- فرض کنید C مرز جهت دار ناحیه مربعی شکل $0 \leq x \leq \pi$ ، $0 \leq y \leq \pi$ واقع در صفحه $z = 2$ در جهت راستگرد باشد. مقدار $\oint_C \sin z dx - \cos x dy + \sin y dz$ کدام است؟

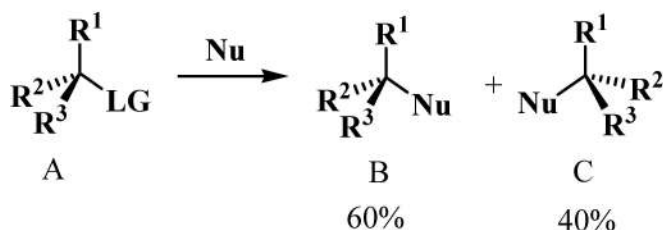
$$2\pi \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (2)$$

$$\frac{2}{\pi} \quad (3)$$

$$\pi \quad (4)$$

۱۱- ترکیب فعال نوری خالص A طی واکنش جانشینی هسته دوستی آلیفاتیک یک جفت انانتیومر B و C را با نسبت $40 : 60$ حاصل می‌کند. چند درصد فراورده طی مکانیسم S_N1 و چند درصد طی S_N2 تولید شده است؟



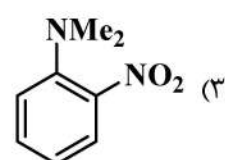
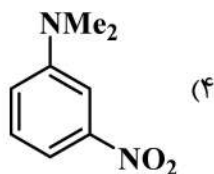
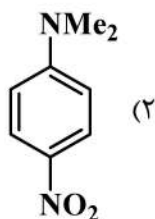
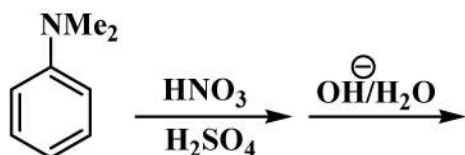
$$(S_N2) \% 20 \text{ و } (S_N1) \% 80 \quad (1)$$

$$(S_N2) \% 40 \text{ و } (S_N1) \% 60 \quad (2)$$

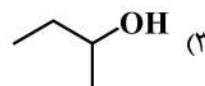
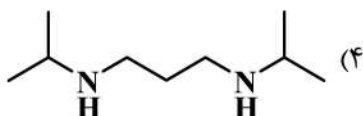
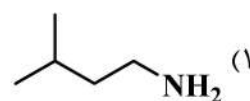
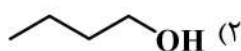
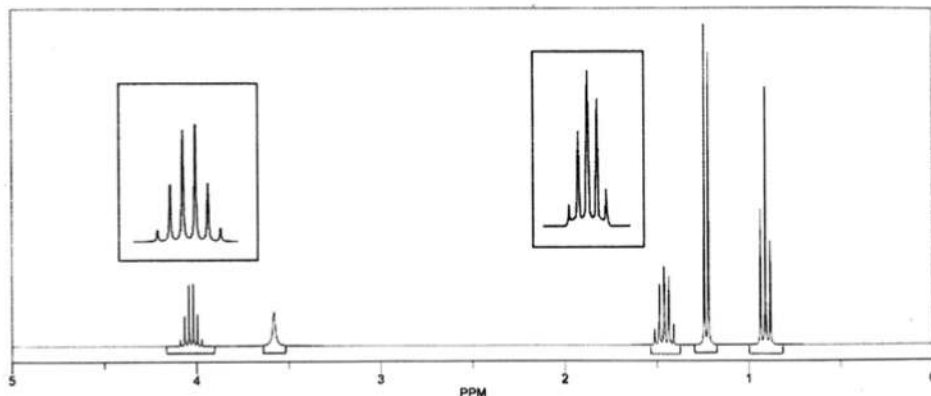
$$(S_N2) \% 60 \text{ و } (S_N1) \% 40 \quad (3)$$

$$(S_N2) \% 80 \text{ و } (S_N1) \% 20 \quad (4)$$

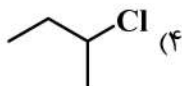
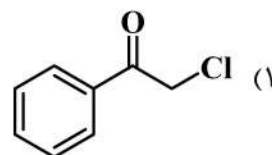
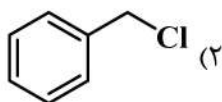
۱۲- محصول واکنش زیر کدام است؟



۱۳- با توجه به طیف $^1\text{H NMR}$ زیر، ساختار ترکیب مربوطه کدام است؟



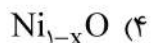
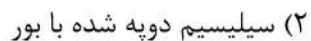
۱۴- کدام یک از ترکیبات زیر هم در واکنش $\text{S}_{\text{N}}2$ و هم در واکنش $\text{S}_{\text{N}}1$ سریع تر از بقیه شرکت می کند؟



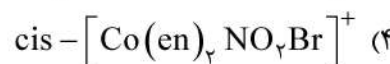
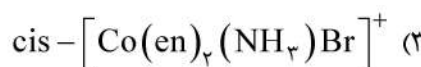
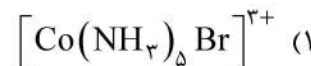
۱۵- در کدام یک از گونه های زیر، زاویه F-S-F بیشتر است؟



۱۶- کدام ترکیب زیر، نیم رسانای نوع p است؟



۱۷- هیدرولیز بازی کدام یک از کمپلکس های زیر، آهسته تر انجام می شود؟



۱۸- چنانچه در کمپلکس $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ لیگاندهای آمین با لیگاندهای CN^- جایگزین شود، چه تأثیری روی

تغییرپذیری آن در واکنش‌های جانشینی لیگاند خواهد داشت؟

(۱) بی اثرتر می‌شود.

(۲) تغییرپذیرتر خواهد شد.

(۳) اثری روی سرعت واکنش جانشینی نخواهد داشت.

(۴) سرعت واکنش جانشینی در محیط بازی بیشتر خواهد شد.

۱۹- اگر $4/4 \text{ mL}$ محلول $1/0 \text{ M HNO}_3$ به رسوبی شامل $24/1 \text{ mg}$ از $\text{Pb}(\text{OH})_2$ و 78 mg از $\text{Bi}(\text{OH})_3$

اضافه شود، چند درصد اسید برای حل کردن رسوب مصرف خواهد شد؟

$$\text{FW}(\text{Bi}(\text{OH})_3) = 260 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

$$\text{FW}(\text{Pb}(\text{OH})_2) = 241 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

(۱) ۱۲/۵

(۲) ۲۵

(۳) ۳۷/۵

(۴) ۵۰

۲۰- در یک روش رسوب‌دهی الکتروشیمیایی (الکترولیز)، برای جدا کردن ۹۹/۹۹٪ از یک آنالیت (M^{n+}) از محلول،

پتانسیل الکتروود کار چقدر جابه‌جا می‌شود؟

(۱) پتانسیل الکتروود کار به اندازه $\frac{0/236}{n} \text{ V}$ به سمت پتانسیل‌های مثبت جابه‌جا می‌شود.

(۲) پتانسیل الکتروود کار به اندازه $\frac{0/178}{n} \text{ V}$ به سمت پتانسیل‌های مثبت جابه‌جا می‌شود.

(۳) پتانسیل الکتروود کار به اندازه $\frac{0/236}{n} \text{ V}$ به سمت پتانسیل‌های منفی جابه‌جا می‌شود.

(۴) پتانسیل الکتروود کار به اندازه $\frac{0/178}{n} \text{ V}$ به سمت پتانسیل‌های منفی جابه‌جا می‌شود.

۲۱- کدام یک از عوامل زیر باعث افزایش شدت فلوروسانس در محلول می‌گردد؟

(۱) کاهش دمای محلول، افزایش شدت منبع تابش، کاهش اکسیژن محلول

(۲) افزایش دمای محلول، کاهش شدت منبع تابش، کاهش اکسیژن محلول

(۳) کاهش دمای محلول، افزایش شدت منبع تابش، اشباع نمودن محلول از اکسیژن

(۴) کاهش دمای محلول، کاهش شدت منبع تابش، افزایش نمک فلزی سنگین

۲۲- کدام مورد، مقایسه ارتفاع بشقابک‌های فرضی (H) و سرعت خطی فاز متحرک را در کروماتوگرافی مایع (LC) و

کروماتوگرافی گازی (GC) به درستی نشان می‌دهد؟

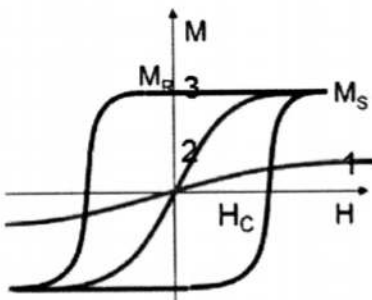
(۱) ارتفاع بشقابک‌ها و سرعت خطی فاز متحرک در LC بیشتر است.

(۲) ارتفاع بشقابک‌ها و سرعت خطی فاز متحرک در GC بیشتر است.

(۳) ارتفاع بشقابک‌ها در LC بیشتر و سرعت خطی فاز متحرک در GC کمتر است.

(۴) ارتفاع بشقابک‌ها در LC کمتر و سرعت خطی فاز متحرک در GC بیشتر است.

- ۲۳- مطابق نظریه جنبشی گازها سهم درجات آزادی ارتعاشی کدام گازها در انرژی درونی بیشتر است؟
 (۱) H_2O (۲) CO_2 (۳) H_2S (۴) HCO
- ۲۴- اختلاف انرژی آزاد گیبس و هلمهولتز، برابر با کدام گزینه است؟
 (۱) p (۲) T (۳) TS (۴) pV
- ۲۵- برای سیستمی که معادله حالت آن، به شکل زیر باشد، کار انجام شده در نتیجه انبساط، متناسب با کدام گزینه است؟
 ثابت $pV^{3/5} =$
 (۱) $V^{3/5}$ (۲) $V^{+2/5}$
 (۳) $V^{-2/5}$ (۴) $V^{-3/5}$
- ۲۶- یکی از روش‌های سنتز نانو ذرات Fe_3O_4 ، از طریق انجام فرایند سل - ژل در حفرات زئولیت‌ها می‌باشد. این روش جزء کدام یک از روش‌های سنتز زیر محسوب می‌شود؟
 (۱) ترمودینامیکی و قالبی
 (۲) سینتیکی و قالبی
 (۳) ترمودینامیکی و خود تمام‌شونده
 (۴) سینتیکی و خود تمام‌شونده
- ۲۷- کدام عبارت در رابطه با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) صحیح است؟
 (۱) حالت تماسی میکروسکوپ نیروی اتمی دارای رزولوشن جانبی کمتری است.
 (۲) تنها نیروی مشارکت‌کننده در انحراف کانتیلور در میکروسکوپ نیروی اتمی، نیروی واندروالس است.
 (۳) در حالت نیروی ثابت تغییرات انحراف کانتیلور می‌تواند مستقیماً برای تولید اطلاعات توپوگرافی استفاده شود.
 (۴) از میکروسکوپ نیروی اتمی می‌توان برای دستکاری سطحی و همچنین انواع نانو لیتوگرافی‌ها استفاده کرد.
- ۲۸- برای یک نانو ماده با مساحت سطح ثابت، کدام گزینه درست است؟
 (۱) انرژی سطحی با جذب گونه‌های شیمیایی بر سطح، تغییر نمی‌کند.
 (۲) انرژی سطحی با جذب گونه‌های شیمیایی بر سطح، افزایش می‌یابد.
 (۳) انرژی سطحی با تغییر مکان اتم‌ها یا یون‌های سطح به سمت داخل کاهش می‌یابد.
 (۴) انرژی سطحی با تغییر مکان اتم‌ها یا یون‌های سطح به سمت داخل تغییر نمی‌کند.
- ۲۹- کدام عبارت برای منحنی‌های زیر صحیح است؟
 (۱) ۱: پارامغناطیس - ۲: سوپر پارامغناطیس - ۳: فرومغناطیس
 (۲) ۱: آنتی فرومغناطیس - ۲: پارامغناطیس - ۳: سوپر پارامغناطیس
 (۳) ۱: آنتی فرومغناطیس - ۲: فرومغناطیس - ۳: پارامغناطیس
 (۴) ۱: دیامغناطیس - ۲: پارامغناطیس - ۳: فرومغناطیس
- ۳۰- کدام عبارت زیر، در رابطه با حالات تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) صحیح است؟
 (۱) در هر دو تصویربرداری حالت میدان روشن و میدان تاریک، تغییر در ساختار بلوری قابل مشاهده است.
 (۲) در تصویربرداری حالت میدان تاریک، تنها پرتوهای عبوری منحرف شده بررسی می‌گردد.
 (۳) در تصویربرداری حالت میدان روشن، از آن دسته پرتوهای عبوری از نمونه استفاده می‌شود که با زاویه زیادی از مسیر ورودی پراکنده شده‌اند.
 (۴) در تصویربرداری حالت معمولی، نقش پرتوهای عبوری منحرف نشده نسبت به پرتوهای عبوری منحرف شده در تشکیل تصویر اهمیت بیشتری دارد.



۳۱- در تهیه نانو ذرات نیمه هادی، کدام یک از جملات زیر نادرست است؟

- (۱) مسیر استوالد منجر به تهیه نانو ذرات بزرگ‌تر می‌شود.
- (۲) رسوب‌گذاری اندازه‌گزی‌نشی منجر به تک‌سایز شدن نانو ذرات خواهد شد.
- (۳) استفاده از مولکول‌های آلی جهت رشد نفوذ کنترل نانو ذرات نیمه هادی بسیار مهم است.
- (۴) در صورت دادن زمان بیشتر به محلول واکنش، پس از کامل شدن آن، توزیع سایز ذرات باریک می‌شود.

۳۲- چاه‌های کوانتومی مربوط به کدام دسته از نانو ساختارها هستند؟

- (۱) یک بعدی
- (۲) دو بعدی
- (۳) سه بعدی
- (۴) صفر بعدی

۳۳- اگر شکاف انرژی (Band Gap) در نانو ذره کروی روی سلنید با اندازه ۲ نانومتر $3/2$ الکترون ولت باشد، شکاف

انرژی برای همین ذره با قطر ۸ نانومتر چند الکترون‌ولت است؟

- (۱) $6/4$
- (۲) $4/8$
- (۳) $2/8$
- (۴) $0/8$

۳۴- یکی از مراحل فرایند سل - ژل برای تولید نانو ذرات، به‌طور معمول تهیه «محلول همگن» از ماده اولیه آلی - فلزی

در یک حلال است. ترتیب مراحل فرایند سل - ژل کدام است؟

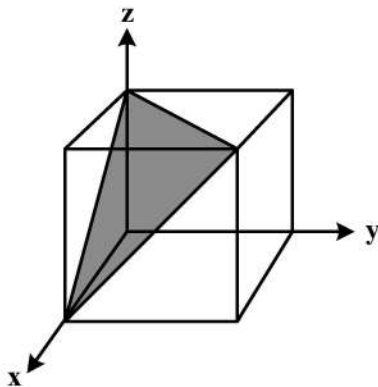
- (۱) تهیه سل از ماده اولیه آلی-فلزی، تبدیل سل به محلول همگن، تبدیل محلول همگن به ژل و تبدیل ژل به فراورده نهایی
- (۲) تهیه ژل از ماده اولیه آلی-فلزی، تبدیل ژل به محلول همگن، تبدیل محلول همگن به سل و تبدیل سل به فراورده نهایی
- (۳) تبدیل محلول همگن به ژل، تبدیل ژل به سل و تبدیل سل به فراورده نهایی
- (۴) تبدیل محلول همگن به سل، تبدیل سل به ژل، تبدیل ژل به فراورده نهایی

۳۵- کدام عبارت زیر، در رابطه با تصویربرداری در حالت ارتفاع ثابت میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)، صحیح است؟

- (۱) پاسخ سیستم بازخورد (feedback) نسبتاً کند (یا کاملاً خاموش) است تا فقط جریان متوسط ثابت بماند.
- (۲) در حالت ارتفاع ثابت، اندازه‌گیری سطوح ناصاف با دقت بیشتری نسبت به حالت جریان ثابت انجام می‌شود.
- (۳) سیستم بازخورد (feedback) ارتفاع سوزن را در راستای محور Z تغییر می‌دهد تا ارتفاع را ثابت نگه دارد.
- (۴) نمودار ولتاژ Z-پیزو در برابر مختصات X و Y سوزن، نقشه‌ای از توپوگرافی فیزیکی سطح را فراهم می‌کند.

۳۶- اندیس میلر مربوط به صفحه زیر کدام است؟

- (۱) (-111)
- (۲) (111)
- (۳) $(11-1)$
- (۴) $(1-11)$



۳۷- یکی از روش‌های ساخت نانو میله‌ها و نانو لوله‌ها، به‌کارگیری تمپلیت حفره‌دار است. کدام عامل / عامل‌ها در اینکه

فراورده نانو میله یا نانو لوله باشد، مؤثر است؟

- (۱) تنها عامل مؤثر، چسبندگی بین دیواره حفره‌ها و مواد پرکننده است.
- (۲) تنها عامل مؤثر، چگونگی انقباض حین انجماد مواد پرکننده است.
- (۳) چسبندگی بین دیواره حفره‌ها و مواد پرکننده و چگونگی انقباض حین انجماد مواد پرکننده، هر دو مؤثر هستند.
- (۴) چسبندگی بین دیواره حفره‌ها و مواد پرکننده و چگونگی انقباض حین انجماد مواد پرکننده، هیچ نقشی ندارند.

- ۳۸- علت تغییر رنگ نانو ذره طلا با افزایش اندازه نانو ذره به سمت قرمز، کدام مورد می باشد؟
 (۱) افزایش تفرق رایلی
 (۲) افزایش طول موج پلاسمون سطحی
 (۳) افزایش شکاف انرژی (باند گپ)
 (۴) حرکت دانسیته حالت به سمت نیمه رسانا
- ۳۹- نانو ساختارهای یک جامد کریستالی با ساختار مکعبی مرکز وجه پر (FCC)، در دمای محیط، در راستای کدام صفحه کریستالی تمایل به تشکیل دارد؟
 (۱) (۱۱۱)
 (۲) (۱۱۰)
 (۳) (۱۰۰)
 (۴) (۰۰۰)
- ۴۰- تکنیک طیفسنجی الکترون اوزه (AES) نسبت به کدام یک از عناصر زیر حساس نیست؟
 (۱) آرگون
 (۲) اکسیژن
 (۳) کربن
 (۴) هلیوم
- ۴۱- عوامل مؤثر در فرایند سونوشیمی (به کارگیری امواج فراصوت) برای تولید نانو ذرات، کدام اند؟
 (۱) مواد اولیه، مواد سطح فعال افزودنی، شدت امواج و زمان اعمال امواج
 (۲) فقط مواد اولیه و مواد سطح فعال افزودنی
 (۳) فقط مواد اولیه و زمان اعمال امواج
 (۴) فقط شدت امواج و زمان اعمال امواج
- ۴۲- در کدام یک از تکنیک های زیر استفاده از شرایط خلاء فوق بالا (UHV) برای بررسی نمونه ضروری نیست؟
 (۱) طیفسنجی الکترون اوزه (AES)
 (۲) میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
 (۳) میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی (STEM)
 (۴) طیفسنجی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS)
- ۴۳- کدام یک از جملات زیر، در مورد روش سنتز سینتیک نادرست است؟
 (۱) سنتز سینتیک به این معنی است که رشد ذرات را محدود می نماییم.
 (۲) در روش سنتز سینتیک، رشد زمانی متوقف می شود که فضای مورد نیاز جهت رشد پر شود.
 (۳) در روش سنتز سینتیک، رشد زمانی متوقف می شود که مقدار ماده مورد نیاز تمام شود.
 (۴) روش سنتز سینتیک به این معنی است که در این روش سنتز نانو ذرات با سرعت بالایی پیش می رود.
- ۴۴- کنترل شرایط سنتز کدام یک از نانو ذرات زیر، نسبت به سایرین سخت تر است؟
 (۱) SiO_2
 (۲) CdS
 (۳) Ag
 (۴) Au
- ۴۵- نانو ذره ای با قطر ۳۰ نانومتر، ۵ درصد از اتمها را در سطح دارد. نانو ذره با قطر ۵ نانومتر چند درصد اتمها را در سطح خواهد داشت؟
 (۱) ۸۰
 (۲) ۶۵
 (۳) ۳۰
 (۴) ۱۰

مشاهده کلید اولیه سوالات آزمون دکتری 1400

کلید اولیه آزمون دکتری سال 1400

به اطلاع می‌رساند، کلید اولیه سوالات که در این سایت قرار گرفته است، غیر قابل استناد است و پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظرات کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می‌توانید حداکثر تا تاریخ 1400/01/03 با مراجعه به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به تکمیل فرم "اعتراض به کلید سوالات" / "آزمون دکتری سال 1400" اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط تا تاریخ مذکور و از طریق فرم ذکر شده دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر (نامه مکتوب یا فرم عمومی در سامانه پاسخگویی و ...) یا پس از تاریخ اعلام شده رسیدگی نخواهد شد.

عنوان دفترچه	نوع دفترچه	شماره پاسخنامه	گروه امتحانی
نانوشیمی	A	1	علوم پایه

شماره سوال	گزینه صحیح	شماره سوال	گزینه صحیح
1	4	31	3
2	3	32	2
3	1	33	3
4	2	34	4
5	3	35	1
6	1	36	4
7	3	37	3
8	2	38	2
9	4	39	1
10	1	40	4
11	1	41	1
12	4	42	2
13	3	43	4
14	2	44	1
15	3	45	3
16	4		
17	2		
18	1		
19	2		
20	3		
21	1		
22	4		
23	2		
24	4		
25	3		
26	2		
27	4		
28	3		
29	1		
30	2		

خروج